

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体  
光・電子デバイス第 162 委員会  
委員長 岸野 克巳

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会  
第 100 回委員総会・第 104 回研究会 開催案内  
(薄膜第 131 委員会と合同開催)

日時：平成 29 年 6 月 30 日 (金)

委員総会： 12:05 - 13:00

研究会： 13:00 - 17:30

意見交換会： 17:45 - 19:15

(※ 第 131 委員会総会が 11:50~12:05 に同会場で開催されます。)

場所： 京都テルサ B・C 会議室

(JR 京都駅(八条口)より南へ徒歩約 15 分、近鉄東寺駅より東へ徒歩約 5 分)

〒601-8047 京都市南区 東九条下殿田町 70

<http://www.kyoto-terrsa.or.jp/>

### 委員総会

議 題：

- (1) 前回第 99 回委員総会 議事要録 承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) H28 年度収支決算について
- (4) H29 年度予算案について
- (5) 次回第 105 回研究会以降の研究会について
- (6) 特別事業 100 回記念研究会資料編纂予算について
- (7) ISPlasma2018/ICPLANTS2018 (名城大学、2018 年 3 月 4~8 日)への協賛について
- (8) その他

報告事項：

- (1) 平成 30 年度産学協力研究事業(特別事業)への応募について
- (2) 特別事業(シンポジウム) 第 100 回記念公開シンポジウムについて
- (3) 特別事業(研究成果の刊行) 162 委員会 100 回記念研究会資料編纂について
- (4) APWS2019 の開催について
- (5) 第 9 回ナノ構造・エピタキシャル講演会 (北海道大学 7/13,14) 開催案内
- (6) International Workshop on UV Materials and Devices 2017 (九州大学 11/14~18) 開催案内
- (7) International Workshop on Nitride Semiconductors 2018 (金沢県 2018/11/11~16) 開催案内
- (8) その他

研究会 主 題：「化合物半導体エネルギー・光デバイス ～省エネ・創エネ～」

「131 委員長、162 委員長挨拶」, 「企画趣旨説明」 (13 : 00 - 13 : 10)

1. 「GaN パワーデバイスの進展と展望」 (13 : 10 - 13 : 50)  
加地 徹 (名古屋大学)

2. 「SiC パワーMOSFET およびパワーモジュールの開発」 (13 : 50 - 14 : 30)  
御神村 泰樹 (住友電気工業株式会社)
3. 「高効率窒化物半導体発光素子に向けた新展開」 (14 : 30 - 15 : 10)  
竹内 哲也 (名城大学)
- 休憩 (15 : 10 - 15 : 30)
4. 「III-V 化合物太陽電池の高効率化と将来展望」 (15 : 30 - 16 : 10)  
杉山 正和 (東京大学)
5. 「CIGS 系, CdTe 系化合物とペロブスカイト太陽電池」 (16 : 10 - 16 : 50)  
根上 卓之 (パナソニック株式会社)
6. 「Cu<sub>2</sub>O 系太陽電池の高効率化の現状と課題」 (16 : 50 - 17 : 30)  
宮田 俊弘 (金沢工業大学)

-----  
<追記>

1. 6月30日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。  
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 研究会終了後に東館1階 レストラン朱雀に移動し、意見交換会を開催いたします。  
ご出席の際には当日受付で会費 2,000 円(ご同伴者も 2,000 円)をお支払ください。
4. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を6月23日(金)までに日本学術振興会研究事業課 須賀様 (jigyouka06@jsps.go.jp)宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。